

SS218

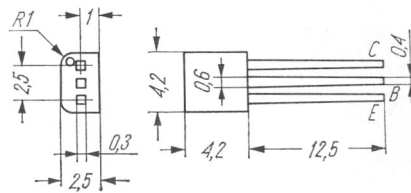
Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-planiarny *n-p-n* w obudowie plastikowej, ciężar około 0,1 G

Zastosowanie: technika cyfrowa

Typy podobne: BSX50, BSX81 (Val, Tel), TIS45 (Tex), 2SC857 (San)



Rys. 1-1085. SS218

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
I_{CBO}	7,5	100	300	nA	przy $U_{CB} = 20$ V
$U_{(BR)CEO}$	15	25		V	przy $I_C = 10$ mA
$U_{(BR)EBO}$	5			V	przy $I_E = 5$ μ A
U_{CEsat}		0,2	0,45	V	przy $I_B = 3$ mA, $I_C = 30$ mA
h_{21E} (A)	18		35		przy $U_{CE} = 0,5$ V, $I_C = 30$ mA
(B)	28		71		
(C)	56		140		
(D)	112		280		
f_T		300		MHz	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 100$ MHz
C_{22b}		2,6		pF	przy $U_{CB} = 10$ V, $I_E = 0$, $f = 2$ MHz
t_{ON}		20	35	ns	przy $I_C = 10$ mA, $I_{B1} = 3$ mA, $-I_{B2} = 1,5$ mA, $R_L = 270$ Ω
t_{OFF}		35	60	ns	

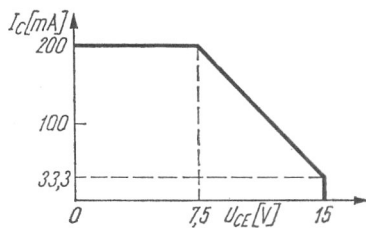
Wartości graniczne

U_{CBO} max	20	V
U_{CEO} max	15	V
U_{EBO} max	5	V
I_C max	100 ²⁾	mA
I_C max	200	mA
I_B max	20	mA
P_{tot} max	200 ³⁾	mW
t_j max	+125	$^{\circ}$ C
t_{amb}	-40 \div +100	$^{\circ}$ C
R_{thj-a}	$\leq 0,5$	$^{\circ}$ C/mW

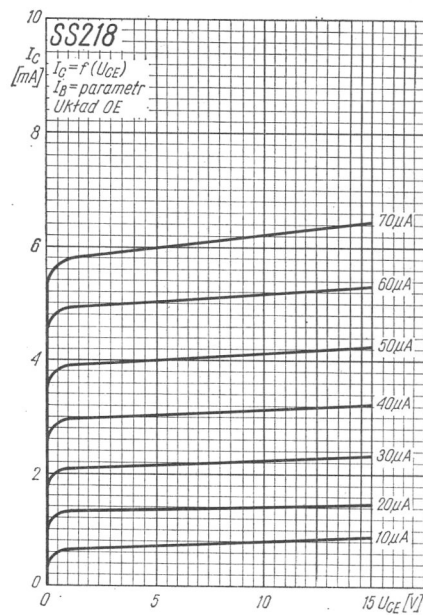
¹⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}$ C (-5 $^{\circ}$ C)

²⁾ $t = 0,9$ μ s

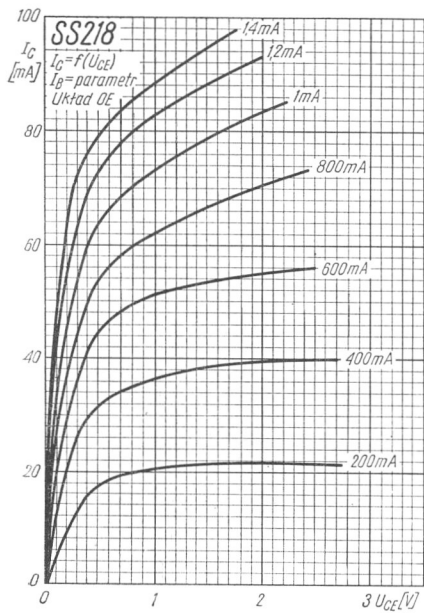
³⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}$ C



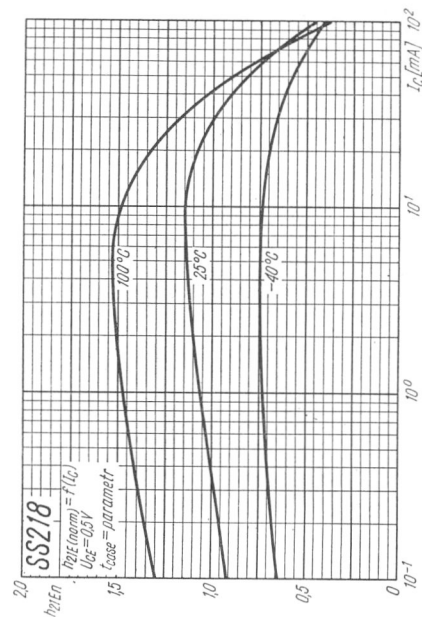
Rys. 1-1086. Dopuszczalny zakres pracy



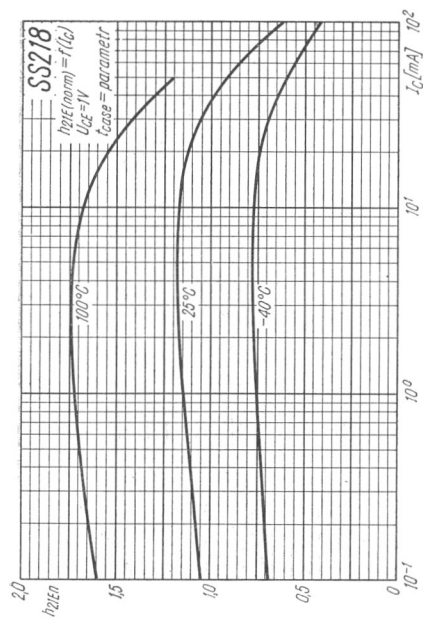
Rys. 1-1087. Charakterystyki wyjściowe



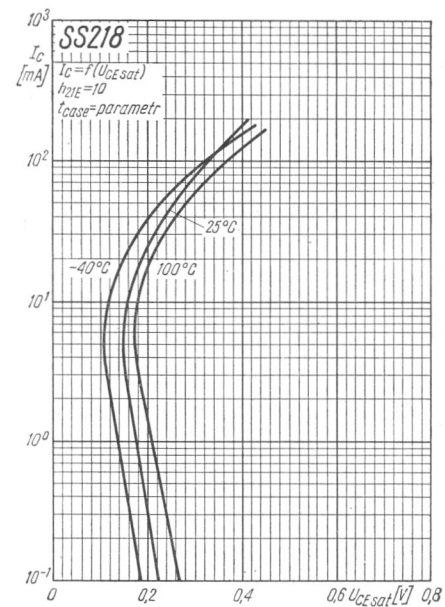
Rys. 1-1088. Charakterystyki wyjściowe



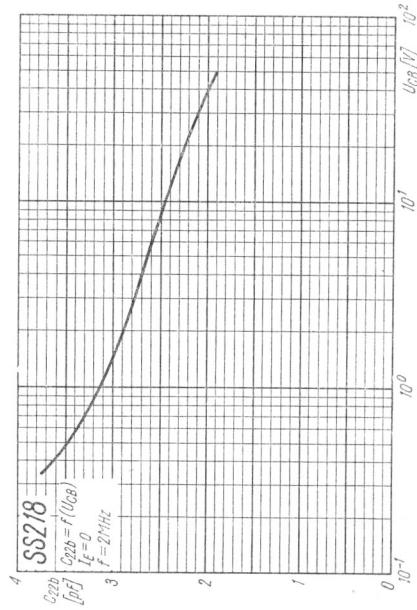
Rys. 1-1089. Zależność normowanego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



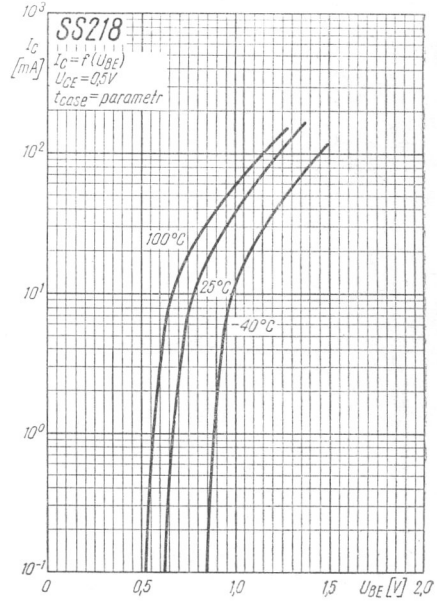
Rys. 1-1090. Zależność normowanego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



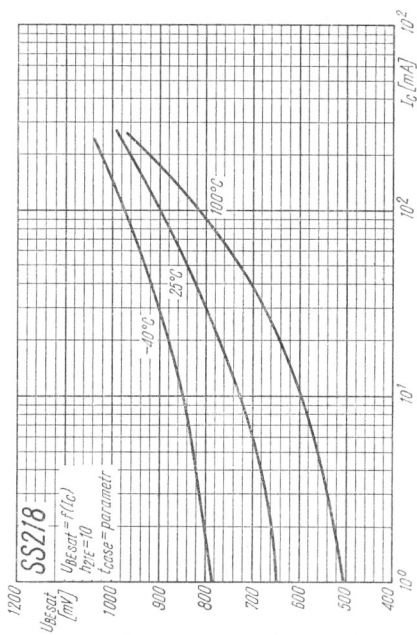
Rys. 1-1091. Zależność napięcia nasycenia kolektora od prądu kolektora



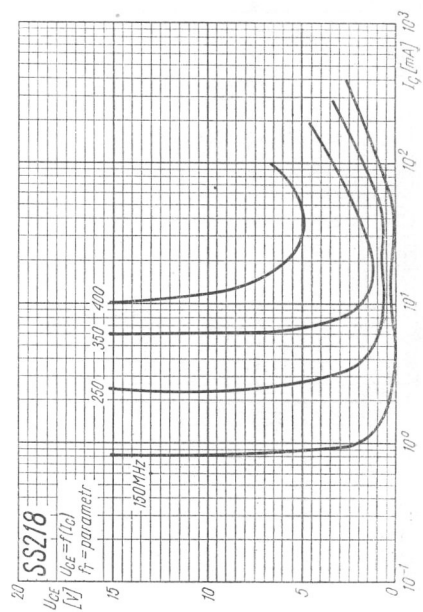
Rys. 1-1092. Zależność pojemności C_{22b} od napięcia



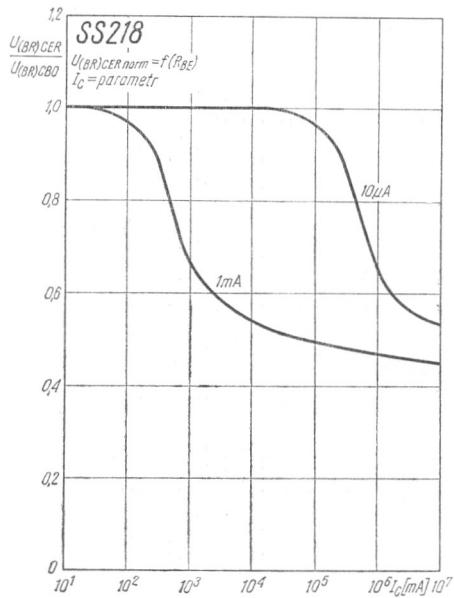
Rys. 1-1093. Charakterystyki sterowania napięciowego



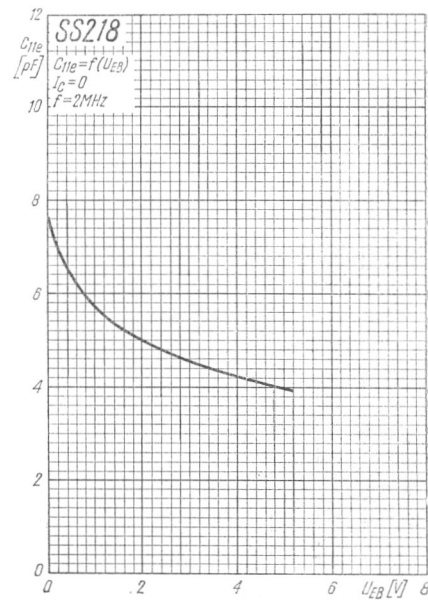
Rys. 1-1094. Zależność napięcia nasycenia bazy od prądu kolektora



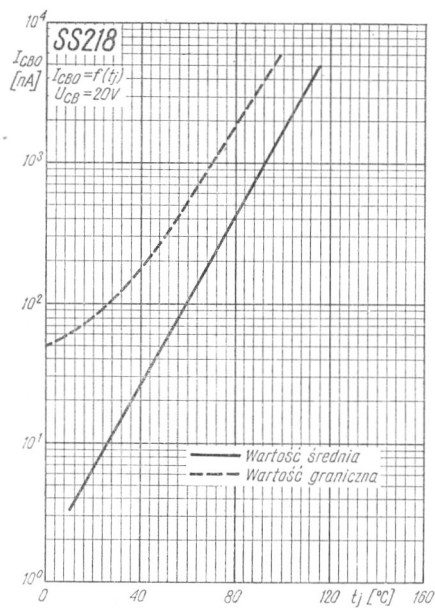
Rys. 1-1095. Zależność prądu kolektora od napięcia kolektora



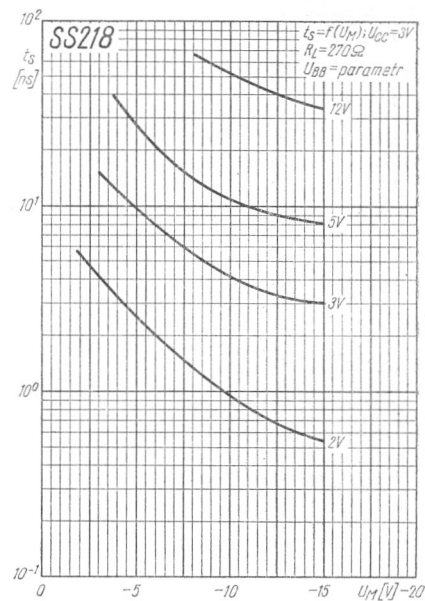
Rys. 1-1096. Zależność napięcia przebicia kolektora od rezystancji R_{BE}



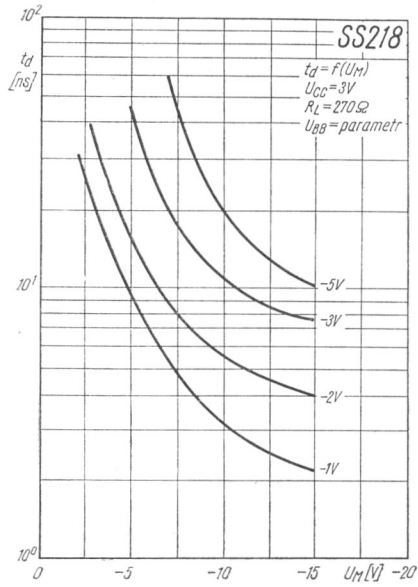
Rys. 1-1097. Zależność pojemności C_{11e} od napięcia



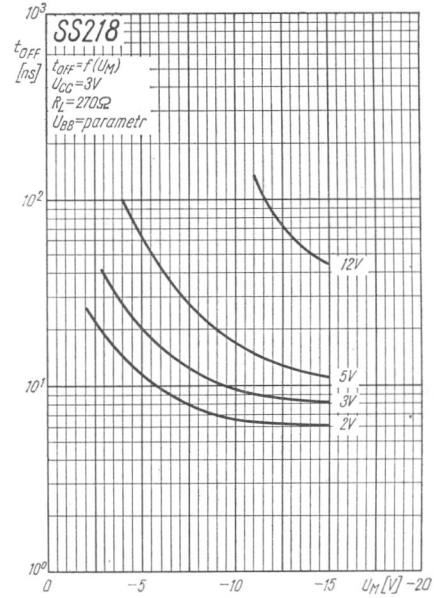
Rys. 1-1098. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury złącza



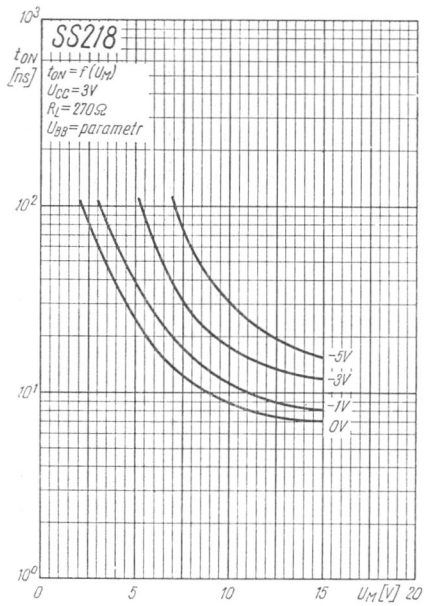
Rys. 1-1099. Zależność czasu magazynowania od napięcia U_M



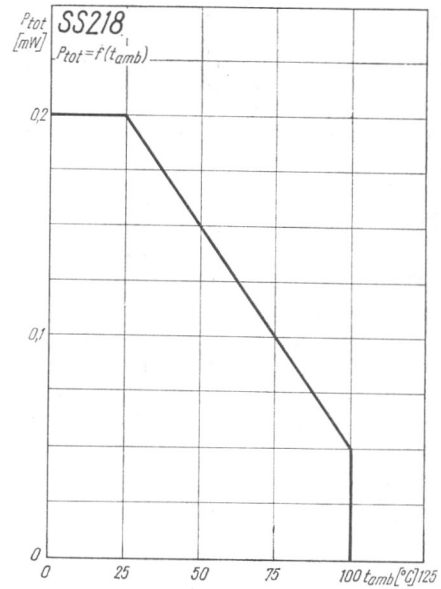
Rys. 1-1100. Zależność czasu opóźnienia od napięcia U_M



Rys. 1-1101. Zależność czasu wyłączenia od napięcia U_M



Rys. 1-1102. Zależność czasu włączania od napięcia U_M



Rys. 1-1103. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia